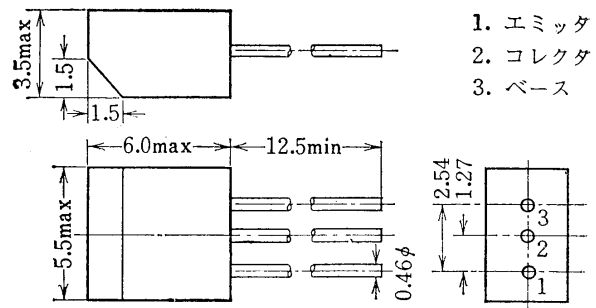


2SC454

シリコン NPN
エピタキシャルプレーナ形
AMラジオ周波数変換用
中間周波増幅用



■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5 V
コレクタ電流	I_C	100 mA
許容コレクタ損失	P_C	200mW
接合部温度	T_j	125 °C
保存温度	T_{stg}	-55~+125 °C

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

	最小	標準	最大
コレクタ・ベース破壊電圧			
BV_{CBO} ($I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$)	30	—	— V
コレクタ・エミッタ破壊電圧			
BV_{CEO} ($I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$)	30	—	— V
エミッタ・ベース破壊電圧			
BV_{EBO} ($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	5	—	— V
コレクタ遮断電流			
I_{CBO} ($V_{CB}=18\text{V}$, $I_E=0$)	—	—	0.5 μA
エミッタ遮断電流			
I_{EBO} ($V_{EB}=2\text{V}$, $I_C=0$)	—	—	0.5 μA
直流電流増幅率*			
h_{FE} ($V_{CE}=12\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$)	60	—	320
ベース・エミッタ電圧			
V_{BE} ($V_{CE}=12\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$)	—	0.63	0.75 V
コレクタ・エミッタ飽和電圧			
$V_{CE(sat)}$ ($I_C=10\text{mA}$, $I_B=1\text{mA}$)	—	0.15	1.1 V
利得帯域幅積			
f_T ($V_{CE}=12\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$)	—	230	— Mc
コレクタ出力容量			
C_{ob} ($V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{Mc}$)	—	2.5	3.5 pF
雑音指数			
NF ($V_{CE}=6\text{V}$, $I_C=0.1\text{mA}$) ($f=1\text{kc}$, $R_g=500\Omega$)	—	—	25 dB

2SC454

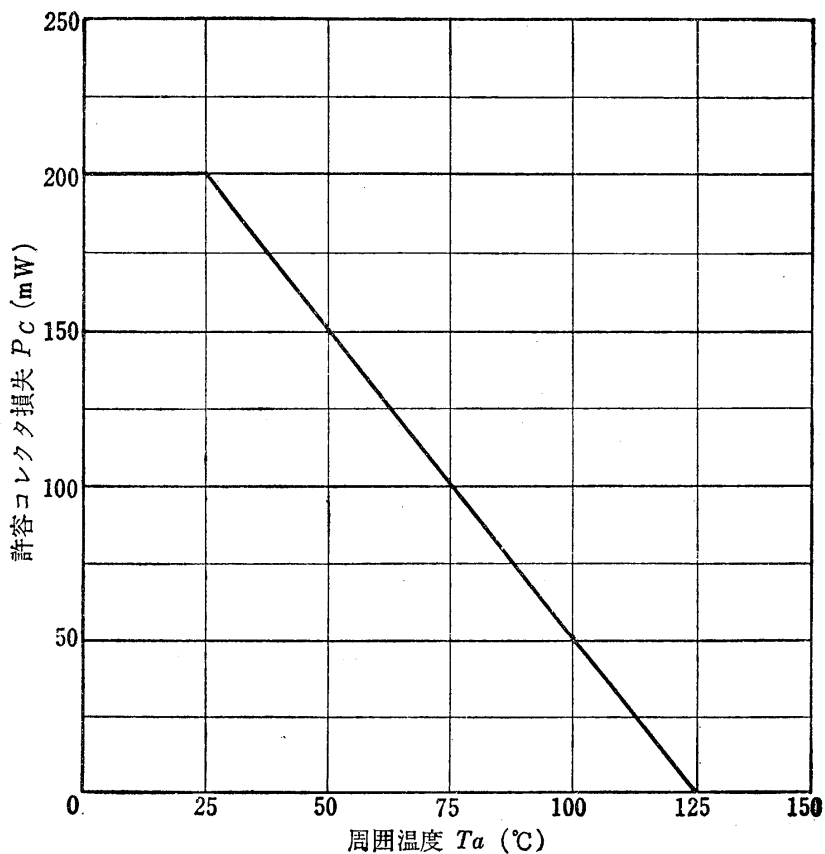
中間周波電力利得

$$IFG \left(\begin{array}{l} V_{CE}=12V, I_C=1mA, f=455kc \\ R_G=1.5k\Omega, R_L=40k\Omega \end{array} \right) \dots\dots\dots - 35 - \text{dB}$$

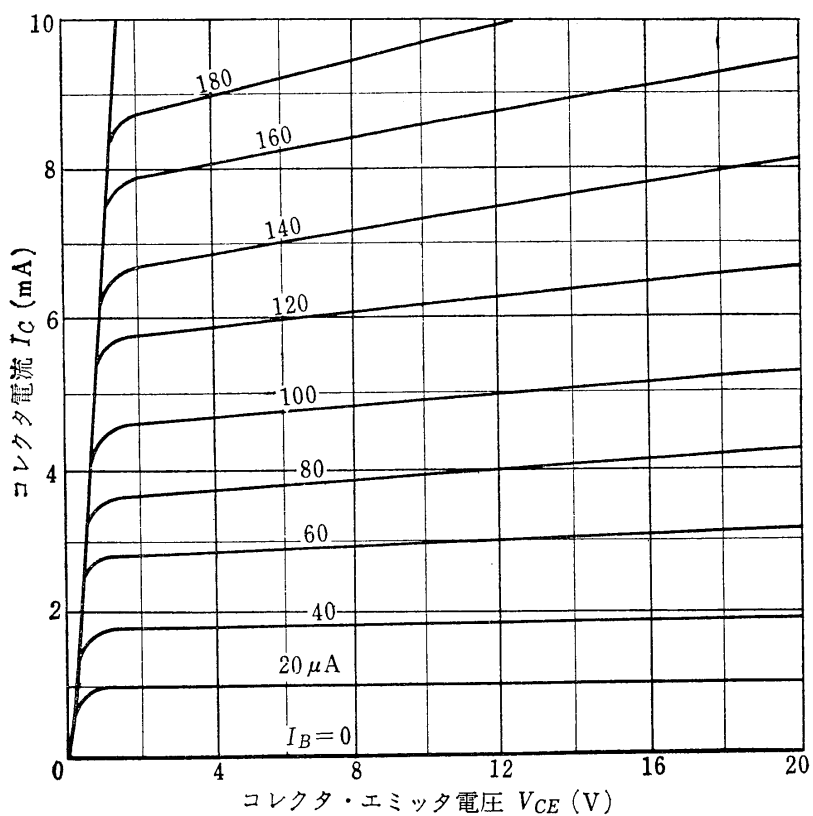
* 2SC454, は h_{FE} により下記のように区分し, 現品にそれぞれⒶ, Ⓑ, Ⓒと表示してあります.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
h_{FE}	60~120	100~200	160~320

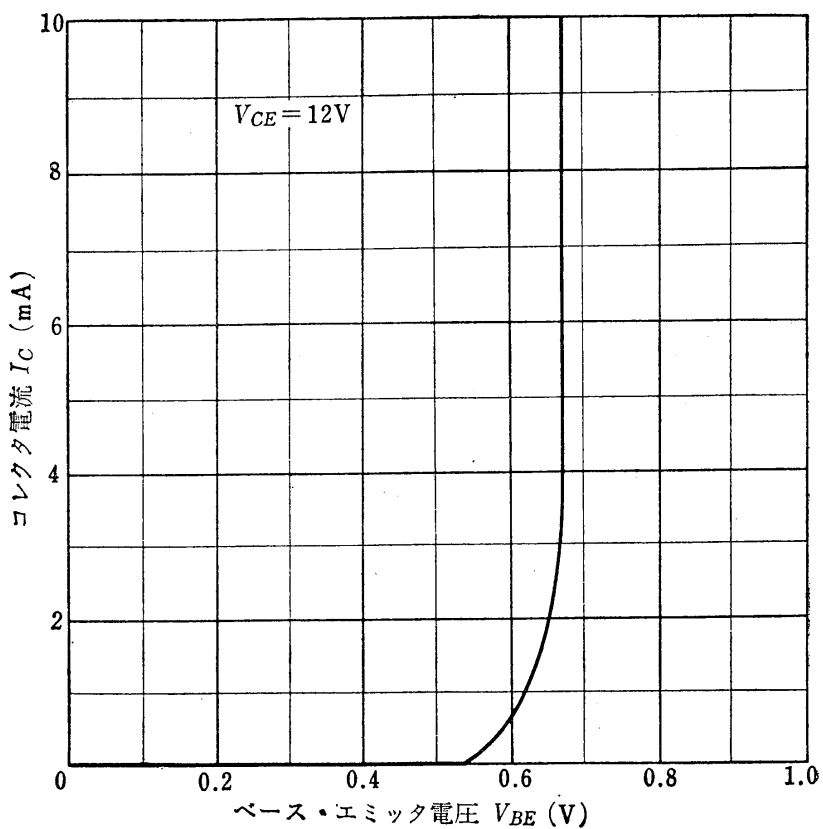
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



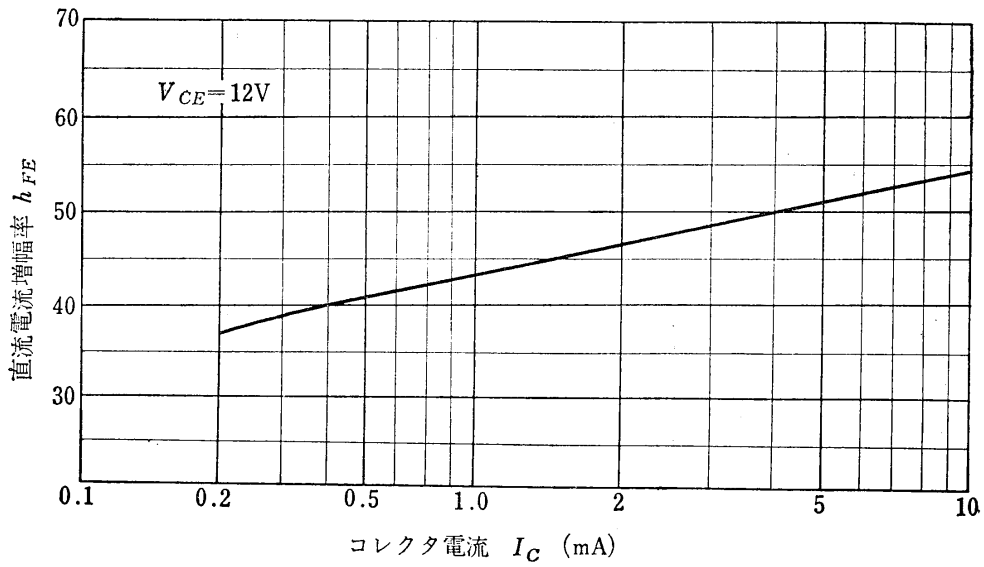
エミッタ接地出力静特性



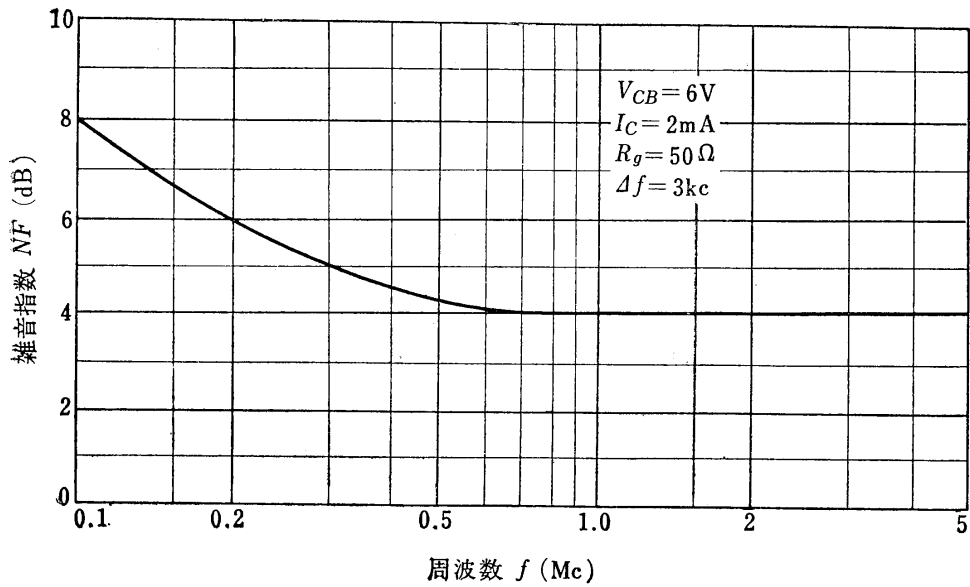
エミッタ接地伝達静特性



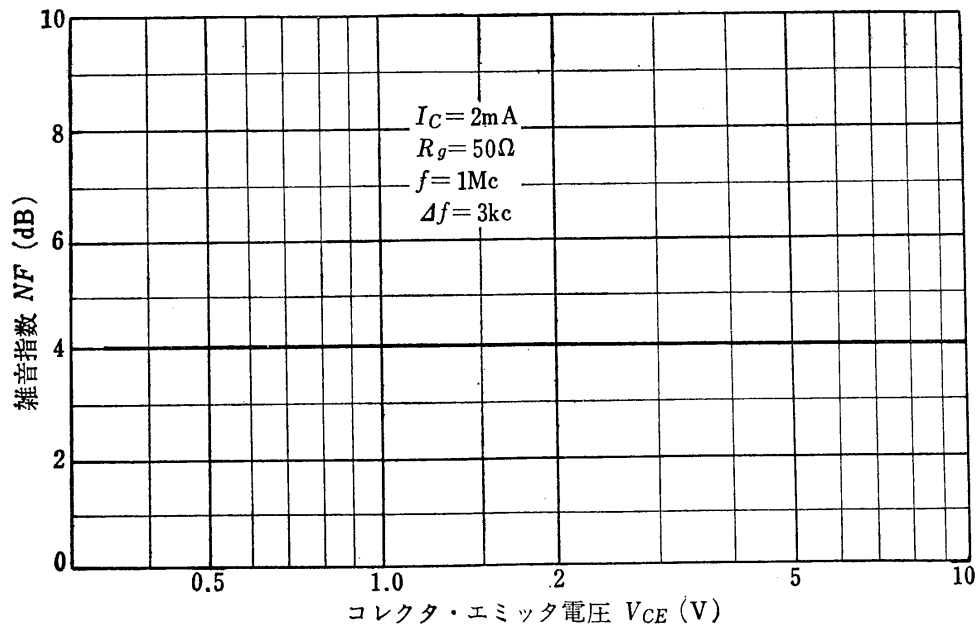
直流電流増幅率対コレクタ電流特性



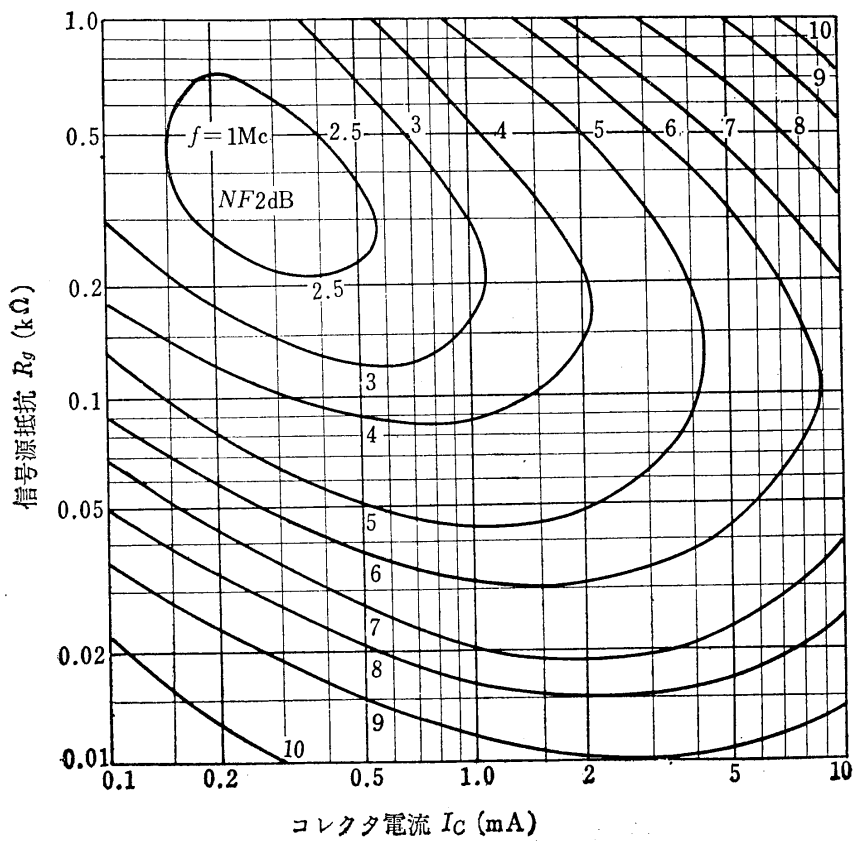
雑音指数対周波数特性



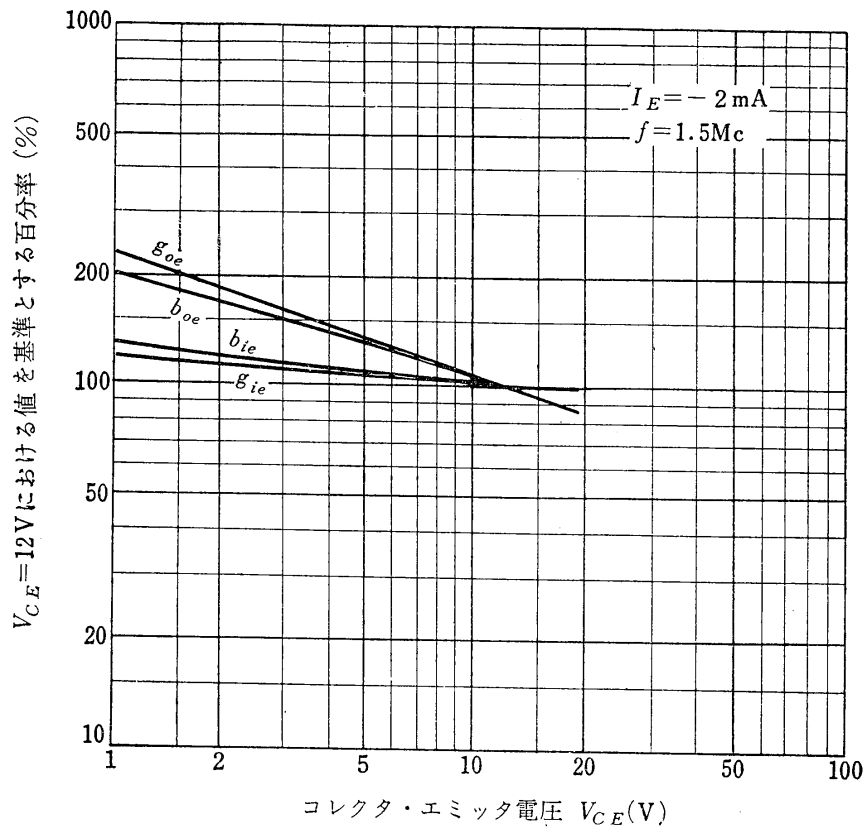
雑音指数対コレクタ・エミッタ電圧特性



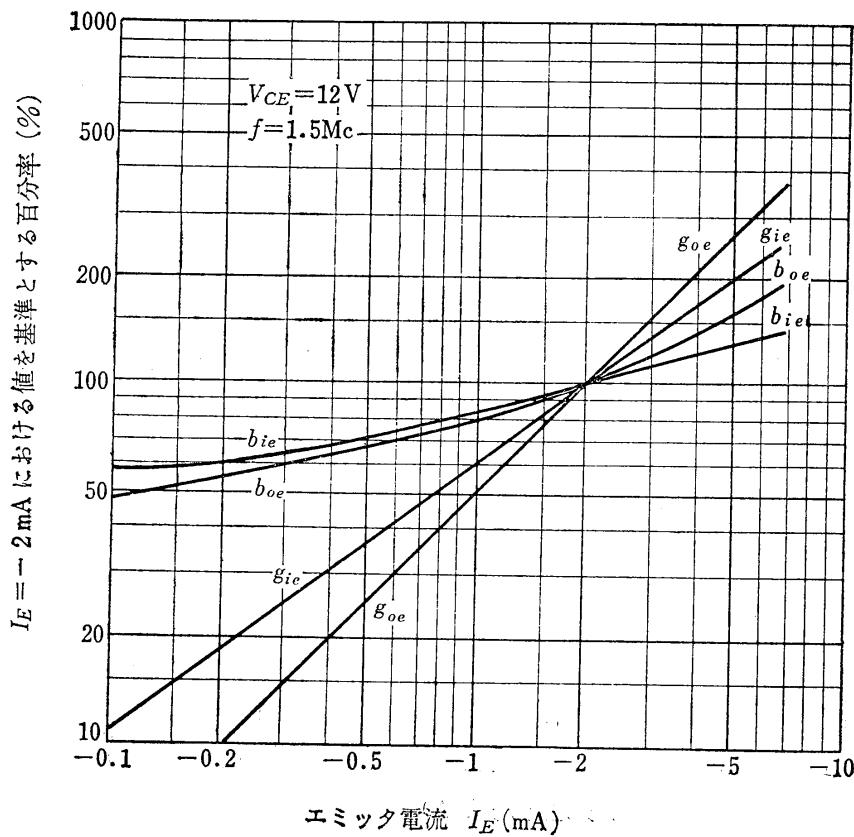
雑音特性



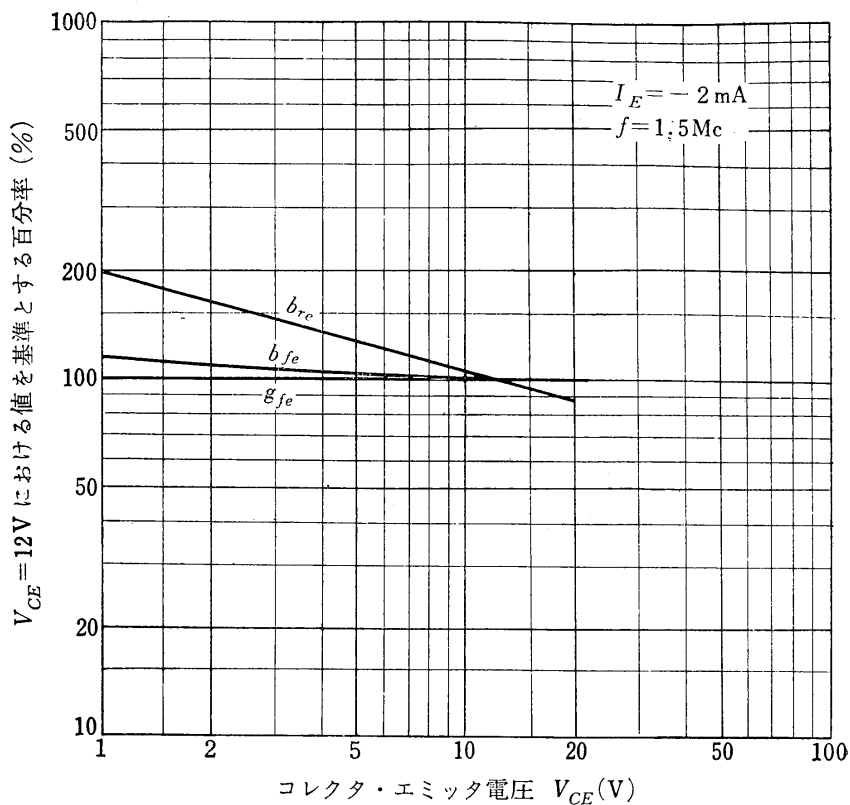
入出力アドミタンス対コレクタ・エミッタ電圧特性



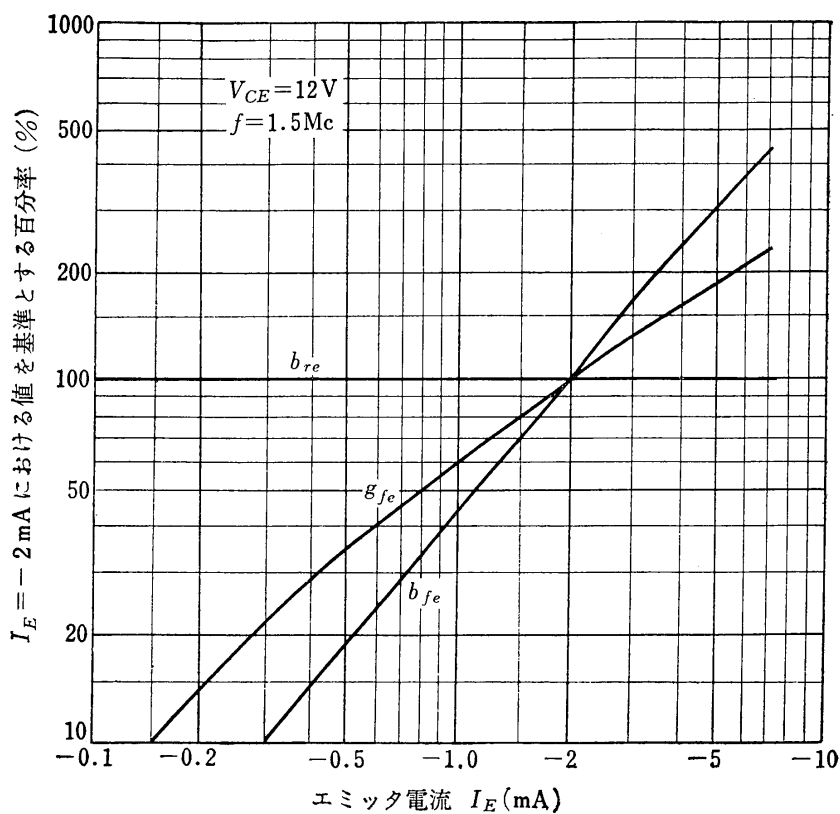
入出力アドミタンス対エミッタ電流特性



伝達アドミタンス対コレクタ・エミッタ電圧特性



伝達アドミタンス対エミッタ電流特性



利得帯域幅積対コレクタ電流特性

